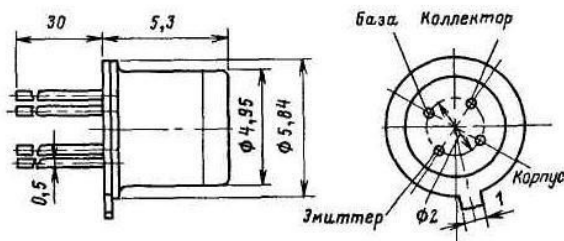


2Т368А, 2Т368Б, КТ368А, КТ368Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* СВЧ усилительные с ненормированным (2Т368Б, КТ368Б) и нормированным (2Т368А, КТ368А) коэффициентами шума на частоте 60 МГц

Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей высокой частоты

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 1 г



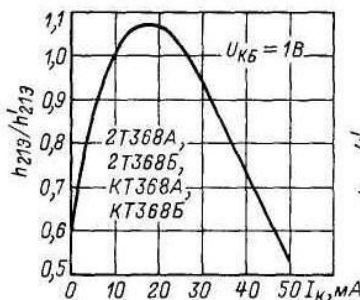
Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА не менее	900 МГц
тип. значение	1100 * МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, $f = 30$ МГц не более	15 пс
тип. значение	7 * пс
Коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, $f = 60$ МГц, $R_Э = 75$ Ом 2Т368А, КТ368А не более	3,3 дБ
тип. значение	2,8 * дБ
Статистический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_К = 10$ мА:	
при $T = 298$ К	50 - 300
при $T = 213$ К 2Т368А, 2Т368Б	25 - 300
при $T = 398$ К 2Т368А, 2Т368Б	40 - 500
Граничное напряжение при $I_Э = 10$ мА не менее	15 В
тип. значение	25 * В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В не более:	
при $T = 298$ К	0,5 мкА
при $T = 398$ К 2Т368А, 2Т368Б	5 мкА
Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К, $U_{ЭБ} = 4$ В, не более	1 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 10$ мА, $f = 1$ кГц не более	6 Ом
тип. значение	3 * Ом
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	1,7 пФ
тип. значение	1,2 пФ
Емкость эмиттерного перехода:	
при $U_{ЭБ} = 1$ В 2Т368А, 2Т368Б не более	3 пФ
при $U_{ЭБ} = 1$ В 2Т368А, 2Т368Б, тип. значение	2 * пФ
при $U_{ЭБ} = 4$ В КТ368А, КТ368Б не более	3 пФ
Емкость конструктивная между выводом эмиттера и корпусом *	0,45 пФ
Емкость конструктивная между выводом коллектора и корпусом *	0,6 пФ
Емкость конструктивная между выводом базы и корпусом *	0,4 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и эмиттера *	0,08 пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и базы *	0,15 пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы * при $l = 3$ мм	4,5 нГн

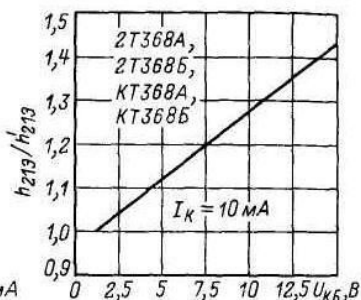
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} < 3$ кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Импульсное напряжение коллектор-база при $\tau_{и} < 0,5$ мс, $Q > 2$	20 В

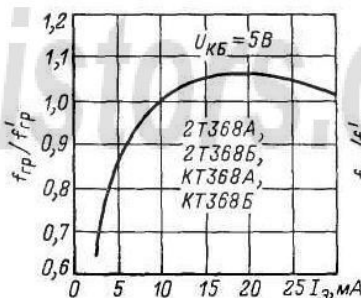
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} < 3$ кОм, $\tau_{и} < 0,5$ мс, $Q > 2$	20 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Постоянный ток эмиттера	30 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} < 0,5$ мс, $Q > 2$	60 мА
Импульсный ток эмиттера при $\tau_{и} < 0,5$ мс, $Q > 2$	60 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 - 338$ К, $p > 6650$ Па	225 мВт
при $T = 213 - 338$ К, $p = 665$ Па	150 мВт
при $T = 398$ К	60 мВт
Общее тепловое сопротивление	364 К/Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К



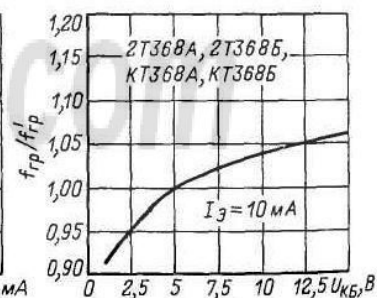
Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



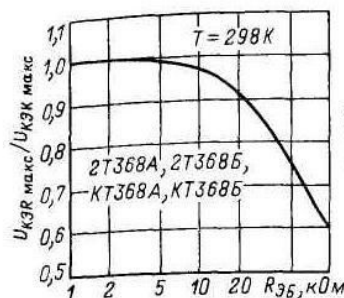
Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база



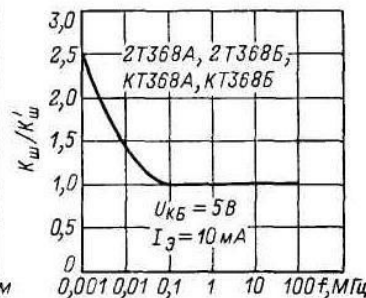
Зависимость относительной граничной частоты от тока эмиттера



Зависимость относительной граничной частоты от напряжения коллектор-база



Зависимость относительного максимально допустимого постоянного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер



Зависимость относительного коэффициента шума от частоты.